# Основи сучасної електроніки

Доцент кафедри ядерної фізики Єрмоленко Руслан Вікторович

Одна з найперших електронно-обчислювальних машин США ENIAC мала

- 18 тисяч електровакуумних приладів (для їх охолодження використовувалась спеціальна установка);
- вага складала десятки тон;
- для розташування ЕОМ було необхідне приміщення площею  $200\text{m}^2$ ,
- для живлення електрична потужність 200 кВт.

Сучасні комп'ютери, маючи значно більше можливостей, вільно розташовуються на письмовому столі і є невід'ємними атрибутами життя сучасного суспільства. Такий стрибок у розвитку обчислювальної техніки стався завдяки революції в електроніці в останні 50 - 60 років.

#### • Перший етап

Початком першого етапу – вакуумної електроніки – вважають 1907 рік, коли американським ученим Л. Форестом був створений підсилювальний електровакуумний прилад – тріод. Цей винахід дав поштовх до розвитку радіотехніки, радіолокації, телебачення, обчислювальної техніки. За відносно короткий проміжок часу були розроблені електровакуумні прилади різного призначення. Проте, незважаючи на низку безперечних переваг, у більшості випадків вони не могли задовольнити нові вимоги до електронної апаратури щодо: надійності, споживання електричної потужності, терміну служби, ваги та габаритів. Останнє особливо важливе для електроніки літальних апаратів.

#### Другий етап

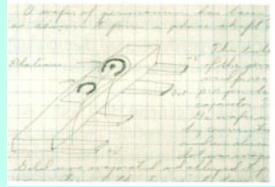
Другий етап розвитку дискретної твердотільної електроніки пов'язують з винаходом у 1947 році американським ученим Браттейном і Д. Бардіним під керівництвом В. Шоклі напівпровідникового підсилювального приладу, який вони назвали **транзистором**.

Навіть перші зразки транзисторів вражали фахівців малими розмірами і затратами спожитої енергії порівняно з електровакуумними приладами, які на той час широко використовувались. Винахід транзистора зробив революцію в електроніці. За цей винахід Браттейну, Бардіну і Шоклі у 1956 р. було присуджено Нобелівську премію. Слідом за транзистором було зроблено багато інших напівпровідникових дискретних приладів: різні класи діодів, тиристорів, польових транзисторів, приладів оптоелектроніки.

#### • Третій етап

Третій етап - народження мікроелектроніки пов'язують зі створенням 1958 року Дж. Кілбі і Нейсом першої мікросхеми. Мікроелектроніка за короткий час пройшла шлях від малих інтегрованих схем з рівнем інтеграції 10<sup>2</sup> елементів на одній кристалічній пластині до надвеликих інтегрованих схем з рівнем інтеграції більше за 108 елементів на одній пластині. Розміри окремих елементів складають долі мікрона. Сучасні технології дозволяють на одному кристалі формувати найскладніші багатофункціональні електронні пристрої і системи. Можна стверджувати, що сучасна електроніка – це в основному електроніка інтегрованих мікросхем. Лише завдяки розвитку мікроелектроніки з'явилась можливість створити супер-ЕОМ, здійснювати космічні польоти, досліджувати інші планети.





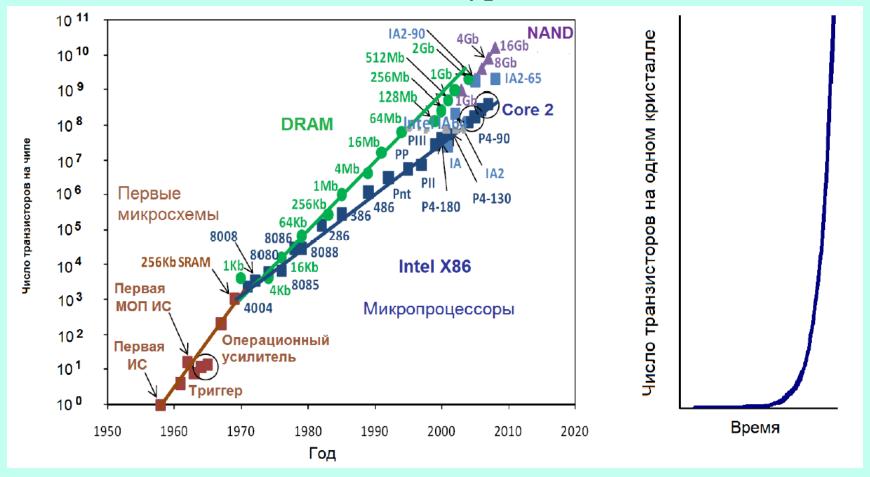
Перша мікросхема та її опис в робочому журналі (генератор)

#### Четвертий етап

Намагання зменшити розміри активних елементів мікросхем спонукало до зародження нового етапу електроніки — **наноелектроніки**. Ми живемо в час переходу від субмікронних до нанометрових розмірів елементів інтегрованих схем. Зменшення розмірів до нанометрів зумовило появу нових квантово-розмірних ефектів, які можна використовувати для створення більш сучасних приладів та пристроїв електроніки. Проте деякі задачі сучасної електроніки (наприклад, розпізнавання мови і візуальних образів) потребують настільки великих обчислювальних потужностей, що дослідники займаються пошуками нових можливостей і розробкою приладів на принципово нових фізичних явищах.

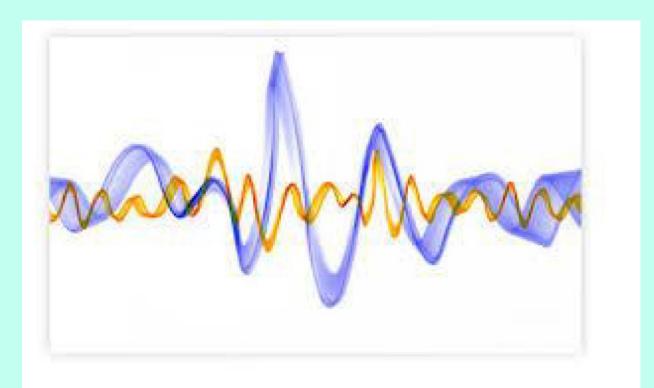
Одна з таких можливостей пов'язана з тим, що електрон – це не просто заряджена частинка, а частинка, яка має внутрішній момент кількості руху – спін, і пов'язаний з ним магнітний момент. Електрон може знаходитись удвох спінових станах, які умовно називають "спін угору " і "спін униз". Цими станами можна кодувати біти інформації: один стан відповідає "1", а другий "0". Існують і інші радикальні альтернативи розвитку наноелектроніки, із яких слід в першу чергу виділити молекулярну електроніку і біоелектроніку. Методи сучасної електроніки знайшли широке застосування в наукових дослідженнях. Народився, зокрема, і такий напрямок, як ядерна електроніка. Вона забезпечила розвиток ядерно-фізичного експерименту, ядерних технологій та широко застосовується в фізиці високих енергій.

## Закон Мура



Число компонентів на інтегральних мікросхемах подвоюється кожні 18-24 місяці

- Сигнал залежність електричної напруги (струму) від часу, що містить наступні компоненти:
- а) однозначно-визначена вимірюваними фізичними величинами ІНФОРМАЦІЯ;
- б) стохастична ШУМ;
- в) стаціонарна або залежна від історії сигналу перешкода.

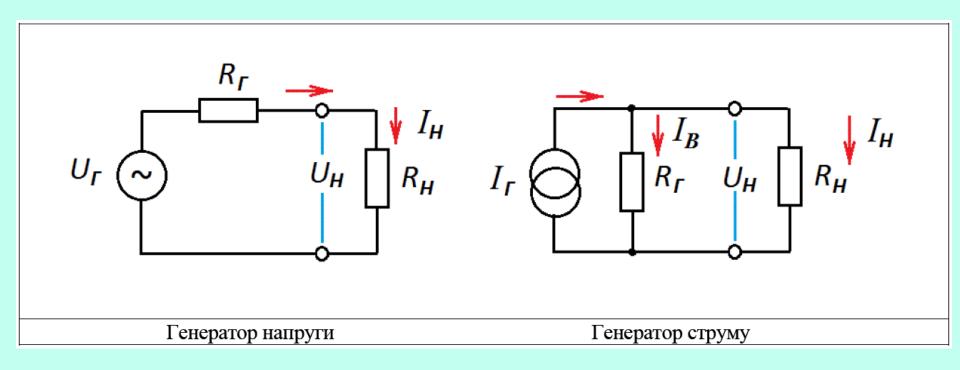


Вимірювальні перетворювачі - клас пристроїв, що перетворюють фізичні величини в сигнал. Інформація на виході вимірювального перетворювача може бути пов'язана не тільки з миттєвим значенням напруги (струму), але і з амплітудою коливань деякої частоти, інтегралом за деякий час, частотою, середньоквадратичним значенням, фазою та іншими параметрами.

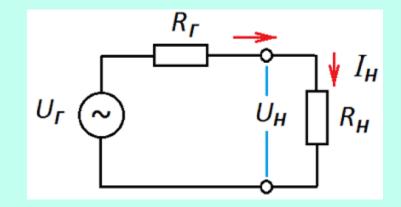
У техніці фізичного експерименту за деякими вимірювальними перетворювачами закріпилася назва "детектор", наприклад, НПД - НапівПровідниковий Детектор іонізуючих випромінювань.

Будь-які джерела сигналів можна описати за допомогою еквівалентної схеми — генератора сигналу.

В залежності від конкретної задачі використовують один з двох типів генераторів: генератор напруги або генератор струму.



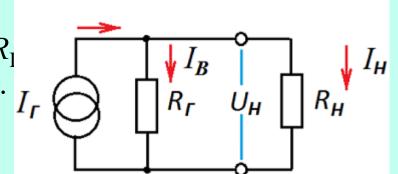
Для генератора напруги мають місце такі співвідношення:



$$I_H = \frac{U_{\Gamma}}{R_{\Gamma} + R_{H}},$$
  $U_H = I_{H} * R_{H} = \frac{U_{\Gamma} R_{H}}{R_{\Gamma} + R_{H}},$ 

тобто в ідеальному генераторі напруги внутрішній опір має наближатися до нуля  $R_{\Gamma} \rightarrow 0$ , при цьому вся напруга генератора буде надходити на опір навантаження. В реальних генераторах напруги бажано, щоб  $R_{\Gamma} << R_{H}$ . Генератор напруги описує джерело, напруга якого не залежить від опору навантаження.

В генераторі струму розгалужується саме струм — частина проходить через внутрішній опір генератора  $R_1$  а частина через опір навантаження. Тобто можна записати:



$$U_H = I_{\Gamma} \frac{R_H R_{\Gamma}}{R_H + R_{\Gamma}},$$

а струм, що проходить через опір навантаження буде:

$$I_{\rm H} = \frac{U_H}{R_{\rm H}} = I_{\Gamma} \frac{R_{\Gamma}}{R_H + R_{\Gamma}} = I_{\Gamma} \frac{1}{1 + R_H/R_{\Gamma}}$$

Весь струм генератора буде протікати через опір навантаження, якщо внутрішній опір генератора струму буде йти до нескінченності  $R_{\Gamma} \rightarrow \infty$ . Генератор струму описує джерело, струм якого не залежить від опору навантаження.

Взагалі електричні сигнали U(t) можуть мати найрізноманітніший характер. Звичайно їх поділяють на три групи:

- ✓ періодичні,
- ✓ неперіодичні
- ✓ статистичні.

Періодичні сигнали :  $U(t)=U(t\pm nT)$ ,

де T - період, n - ціле число (n = 1, 2, 3...).

До найпростіших періодичних сигналів відносяться гармонічні коливання:

 $U(t) = U_0 \sin(\omega t + \varphi)$  and  $U(t) = U_0 \cos(\omega t + \varphi)$ ,  $\omega = 2\pi f = 2\pi/T$ .

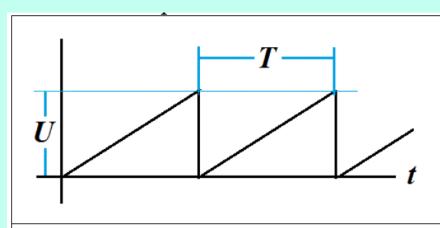
Тут  $U_0$ — амплітуда (вольти),  $\omega$  — циклічна частота (радіан/сек),  $\varphi$  — початкова фаза.

Складні періодичні сигнали з періодом  $T_1$  за допомогою формалізму Фур'є розкладають в ряди по гармоніках:

$$U(t) = \frac{1}{2}a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(\omega_1 nt) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(\omega_1 nt)$$
Тут
$$a_n = \frac{2}{T_1} \int_0^{T_1} U(t) \cos(\omega_1 nt) dt$$

$$b_n = \frac{2}{T_1} \int_0^{T_1} U(t) \sin(\omega_1 nt) dt.$$
Або
$$U(t) = U_0 + \sum_{n=1}^{\infty} U_n \cos(\omega_1 nt - \varphi_n)$$
Де
$$U_0 = a_0/2, \ U_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}, \ n = 1, 2, 3...$$

Таким чином маємо можливість аналізувати складні сигнали аналізуючи їх гармонічні складові.



Графік залежності напруги сигналу від часу.

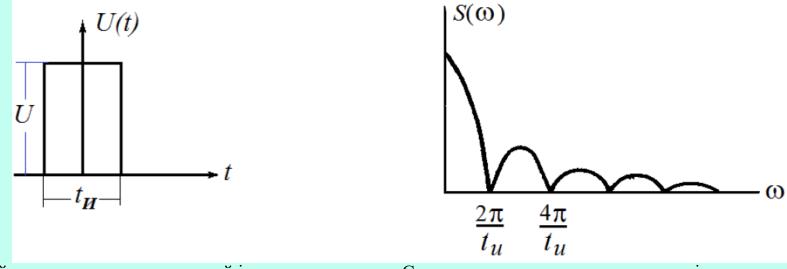
$$U(t) = \frac{U}{2} - \frac{U}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin(n\omega_0 t)$$
$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$$

Його розклад в ряд Фур'є демонструє спектральний склад сигналу (лінійчатий спектр).

З розкладу в ряд видно, що сигнал складається з синусоїд з дискретними частотами  $\omega_0$ , 2  $\omega_0$ , 3  $\omega_0$  ..., амплітуди яких зменшуються як 1/n. Це лінійчатий спектр.

Неперіодичний сигнал (наприклад один прямокутний імпульс) матиме неперервний спектр, який визначається інтегралом Фур'є. Дійсно, неперіодичний сигнал можна розглядати як деяку періодичну функцію, яка має період, що наближається до нескінченності. В цьому випадку розглянута нами вище періодична послідовність імпульсів перейде в одиночний імпульс, тобто сигнал стане неперіодичним. Для знаходження його спектра ми повинні перейти від спектра періодичного до спектру неперіодичного сигналу. При збільшенні періоду T до нескінченності величина  $\omega = 2 \pi / T \rightarrow 0$  прагне стати нескінченно малою. Це означає, що інтервали між лініями спектру за шкалою частот нескінченно малі, тобто ці лінії як би зливаються, і спектр стає суцільним.

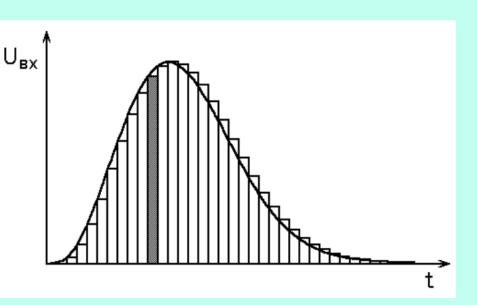
Як приклад розглянемо один прямокутний імпульс тривалістю  $t_{\rm u}$ . Відомо, що спектр такого сигналу має вигляд:



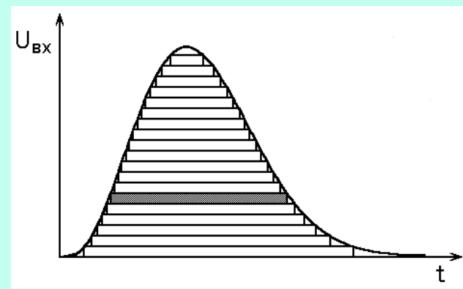
Неперіодичний сигнал – один прямокутний імпульс.

Спектр частот одного прямокутного імпульсу.

Електричні сигнали можуть бути представлені не лише як сума гармонічних функцій. Сигнал можна представити у вигляді суми корортких імпульсів або суми сходинок:



Представлення сигналу у вигляді коротких імпульсів



Представлення сигналу у вигляді сходинок

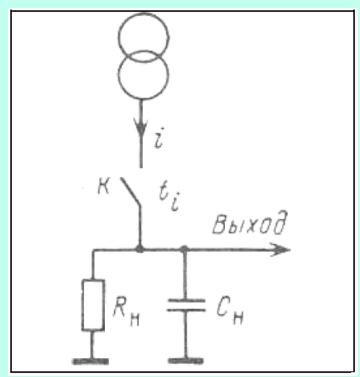
# Сигнали з детекторів ядерного випромінювання

Процес розпаду радіоактивних ядер носить випадковий (статистичний) характер. Тобто випадковими є практично всі параметри ядерного випромінювання: тип і енергія частинок, момент їх появи, часові інтервали між ними. Додаткові невизначеності виникають завдяки складним механізмам взаємодії ядерного випромінювання з речовиною детекторів. Відповідно і сигнали від детекторів ядерного випромінювання мають випадковий характер, що і обумовлює специфічні особливості ядерної електроніки.

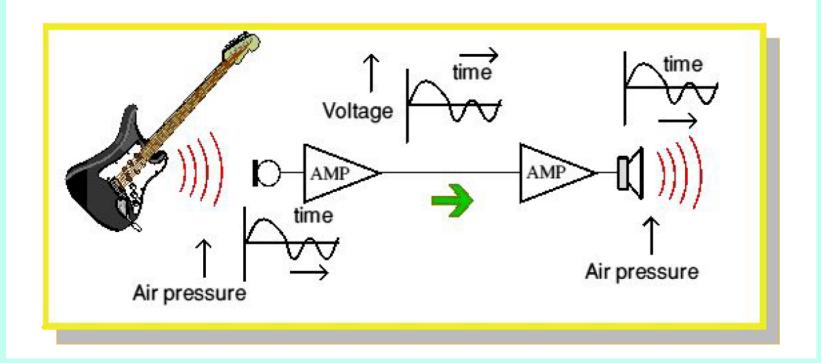
Незважаючи на різноманітність фізичних принципів реєстрації частинок різними типами детекторів, на виході багатьох детекторів з електричним зніманням інформації виникає електричний сигнал певного значення та тривалості, що несе всю доступну інформацію.

Тому з формальної точки зору будь який детектор із згаданих вище може розглядатися як генератор струму, який надходить в зовнішній ланцюг для реєстрації. Для формального аналізу процесу формування та передачі вихідного сигналу детектор може бути представлений у вигляді еквівалентної схеми генератора струму.

Електрична еквівалентна схема підключення детектора (генератор струму)



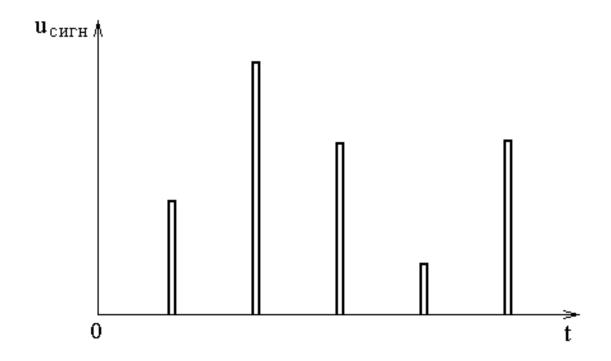
# Аналоговий сигнал



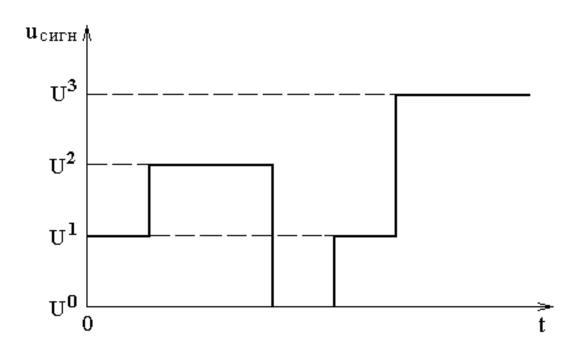
# Аналоговий сигнал довільний по часу та амплітуді



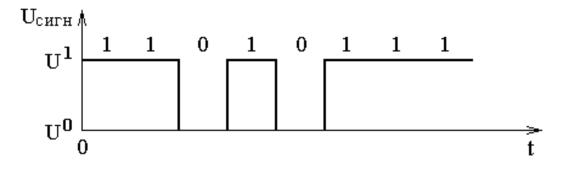
#### Сигнали, довільні по величині та дискретні по часу

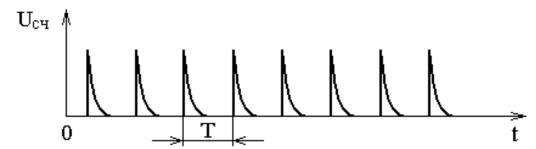


#### Квантовані за значенням та довільні в часі



# **Цифрові сигнали квантовані по величині та** дискретні в часі



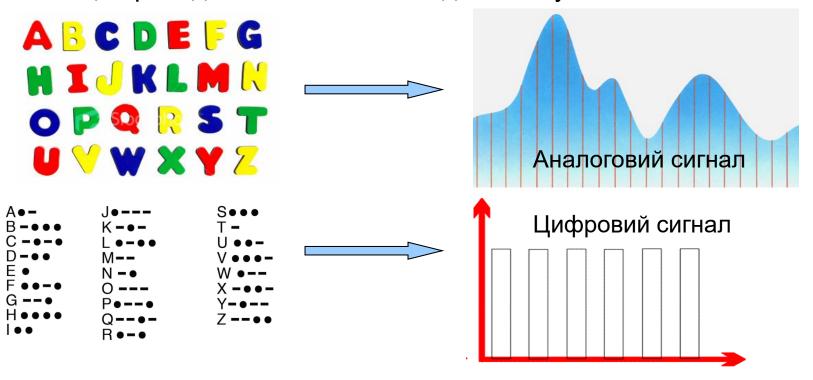


#### Основний недолік аналогового сигналу -

принципова незахищеність від впливу перешкод. Тобто, при обробці аналогового сигналу відношення сигнал / перешкода (сигнал / шум) може тільки погіршитися.

# Цифрові сигнали

Якщо проводити аналоги між видами азбуки та сигналами, то:



**Цифровий сигнал** — електричний сигнал, який описується дискретною функцією часу (дискретний сигнал)

**Цифровий сигнал** має два логічних стани — **0** та **1**. Кожному із цих станів відповідає певний рівень напруги.

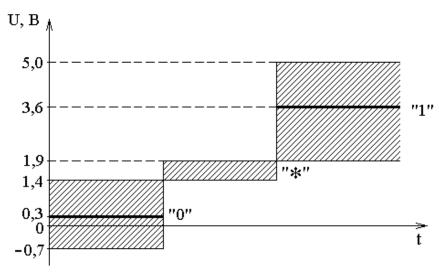
# Цифрові сигнали

- Все, що над шумовим прогом, читається, як «чистий» сигнал
- Несприятливий до невеликих коливань амплітуди сигналу
- На циф ровому сигналі легше будувати логіку
  - Циф рова інф ормація краще зберігається

- Всі сигнали в природі— аналогові. Завжди треба робити перетворення
- Аналоговийностунал має більше характеристик його легше розпізнати в умовах високого ф ону
- Циф рові пристрої повільніші за аналогові

У цифрових сигналах введені спеціальні зони (області допустимих значень), значення сигналів в яких або рівнозначні (незалежно від величини зони), або не можуть існувати взагалі.

Наприклад, в транзисторних-транзисторної логіки (ТТЛ) введено такі допустимі області значень сигналів:



Номинальні значення сигналів для ТТЛ:

$$U_{HOM}^1 = 3.6 B$$
,  $U_{HOM}^0 = 0.3 B$ ;

проте будь-яке значення сигналу в інтервалі від 1,9 В до 5 В буде сприйнято, як логічна "1", в інтервалі від □0,7 В до 1,4 В - як логічний "0". Заборонений інтервал значень сигналів від 1,4 В до 1,9 В ("\*"). Якщо сигнал потрапляє в цей інтервал, то він може бути сприйнятий і як логічний "0", і як логічна "1", що призведе до збою роботи обчислювальних пристроїв.

# Іншою перевагою цифрового сигналу є те, що кожен цикл обробки спрямовує його значення до номінального значення.

#### Наприклад, на вхід пристрою поступив сигнал: $U'_{BX} = 2.1 \, \mathrm{B}$

На виході пристрою сигнал приймає значення:  $U'_{\text{вых}} = 3.5 \text{ B}$ 

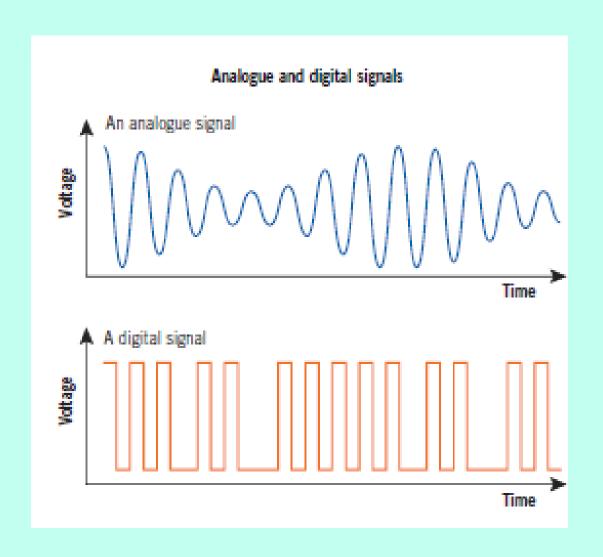
Тобто, при обробці цифрових сигналів відношення сигнал / перешкода (сигнал / шум) не погіршується, а, як правило, покращується.

Отже,

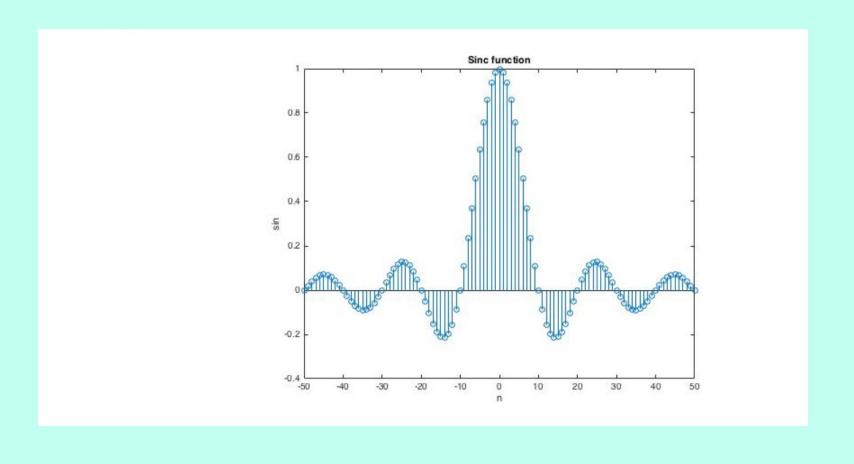
#### цифровий сигнал має значно більшу Захищеність від завад, ніж аналоговий.

Тому в сучасних електронних пристроях аналогові сигнали часто обробляються цифровими методами.

https://youtu.be/j7-acuTio4M https://youtu.be/vFk2MiHRlQo



# Оцифрування аналогового сигналу



# Резистор

Зв'язок між струмом і напругою визначається законом  $U_R = RI$ 

Тут U – напруга на виводах резистора (одиниця виміру - вольт), R – активний опір (одиниця виміру - Ом), I – струм (одиниця виміру - ампер).

У випадку змінного струму :  $I = I_0 \sin(\omega t)$ 

Наруга на резисторі матиме вигляд:

$$U_R = RI_0 \sin(\omega t) = U_0 \sin(\omega t)$$

Тобто для активного опору нема зсуву фаз між струмом і напругою, а опір резистора в певних межах не залежить від частоти.

# Умовні позначення і зовнішній вигляд резисторів

	Постійні резистори	Змінні резистори
Умовні позначення на електричних схемах	R1 — 15 кОм R1	R1 1 кОм
Зовнішній вигляд		R1 10Ω
(SMD - surface mounting device – мініатюрні резистори для монтажу на поверхні друкованих плат).	MAT SMD	Ротор Виводи 1 3 Повзунок

Промисловість виготовляє велику кількість резисторів для найрізноманітніших застосувань. Основні параметри резисторів:

- $\triangleright$  Величина опору  $\sim 10^{-4} < R < 10^{12}$  Ом;
- ightharpoonup Допустима потужність  $\sim 10^{-2} < P = UI < 10^3 \; \mathrm{Bt};$
- ightharpoonup Гарантована точність ~  $10^{-2} \% < \Delta R/R*100\% < 30\%$ ;
- Залежність від температури визначає термічний коефіцієнт опору (ТКР);
- ➤ Частотні властивості для роботи на високих частотах необхідно зменшувати паразитну ємність та індуктивність резистора, що досягається особливостями конструкції.

#### Конденсатор.

Зв'язок між струмом і напругою визначається інтегралом:

$$U_C = \frac{1}{c} \int I(t) dt$$

Тут  $C - \epsilon$ мність (одиниця виміру - фарад). Якщо струм змінюється в часі за законом сінуса

$$I = I_0 \sin(\omega t)$$

То напруга на конденсаторі матиме вигляд:

$$U_{\mathcal{C}}(t) = \frac{1}{C} \int I_0 \sin(\omega t) dt = -\frac{1}{\omega C} I_0 \cos(\omega t)$$

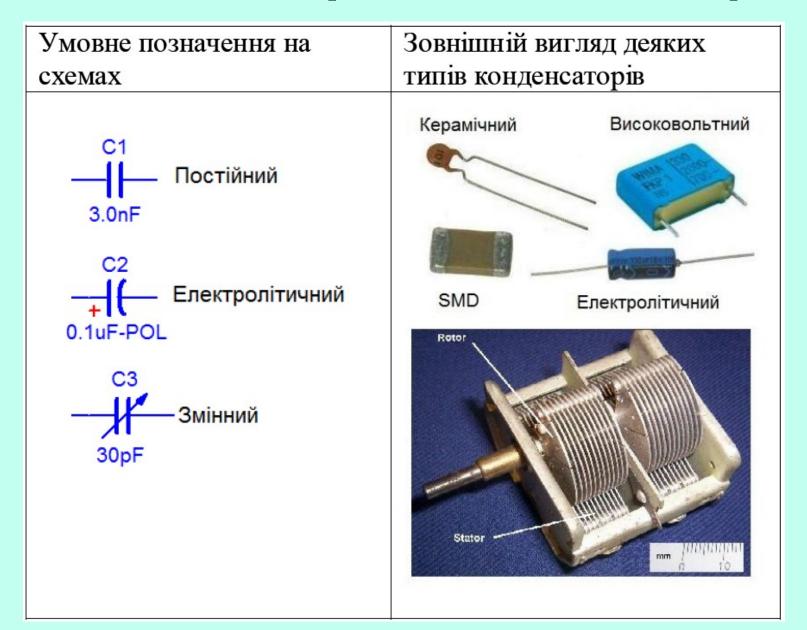
Величина  $\frac{1}{\omega C}$  має розмірність опору, тобто опір ємності залежить від частоти струму. Він позначається як  $Z_C = \frac{1}{\omega C}$ .

Також спостерігається зсув фаз  $\varphi = -\pi/2$  між струмом і напругою (напруга відстає від струму).

#### Основні параметри конденсаторів

- ightharpoonup Смність ~  $10^{-13}$  < C < 1 фаради;
- $\triangleright$  Робоча напруга  $\sim 5 < \text{Uробоча} < 10^5$  вольт;
- Коефіцієнт температурної нестабільності (ТКЕ);
- Максимальна робоча частота.

Умовні позначення та фото деяких типів конденсаторів.



# Пасивні двополюєники Індуктивність (котушка індуктивності).

Зв'язок між струмом і напругою визначається явищем електромагнітної індукції і має такий вигляд:

$$U_L = L \frac{dI}{dt}$$

Якщо струм змінюється в часі за законом сінуса

$$I = I_0 \sin(\omega t)$$

То напруга на індуктивності матиме вигляд:

$$U_L(t) = L\frac{d}{dt}I_0\sin(\omega t) = \omega LI_0\cos(\omega t) = \omega LI_0\sin(\omega t - \frac{\pi}{2})$$

Величина  $\omega L$  має розмірність опору, тобто опір індуктивності залежить від частоти струму. Він позначається як  $Z_L = \omega L$ . Також спостерігається зсув фаз  $\varphi = \pi/2$  між струмом і напругою (напруга випереджає струм).

Умовні позначення та фото деяких котушок.

	Умовне позначення	Зовнішній вигляд
Постійна котушка індуктивності	L1  51mH	
Котушка з можливістю зміни індуктивності	L2 ————————————————————————————————————	